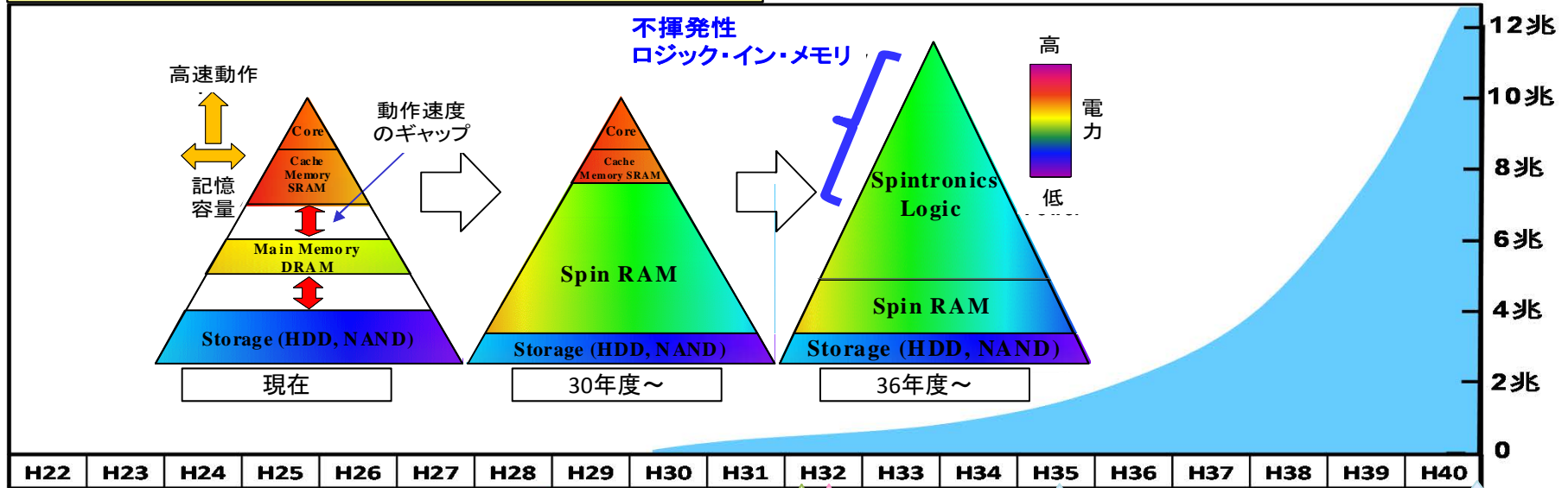


平成26年度科学技術重要施策アクションプラン対象施策  
 「革新的デバイス(不揮発性素子)の開発による効率的エネルギー利用」成果の実用化・事業化 に向けた取組方針

スピントロニクスを適用した半導体チップの市場規模

(WSTS(世界半導体市場統計)2013年春季半導体市場予測より試算)



【エ・経01】ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発

【エ・文12】スピントロニクス技術の応用等による極低消費エネルギーICT基盤技術の開発・実用化

【エ・文07】創発現象を利用した革新的超低消費電力デバイスの開発

消費電力を10分の1にした電子機器の実用化

消費電力を100分の1にする次世代情報デバイスを実用化

消費電力を1000分の1に抑制する次々世代技術を確立

消費電力を1000分の1に抑制する次々世代技術を用いたデバイスの実用化

対象施策名	応用分野	サンプル出荷時期
【エ・経01】ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発	情報端末用プロセッサ	H28年度以降
	監視系センサノード用マイコン	H28年度以降
	生体情報計測用LSI	H28年度以降
【エ・文12】スピントロニクス技術の応用等による極低消費エネルギーICT基盤技術の開発・実用化	ロジック混載SRAM 置換	H28年度
	汎用DRAM置換	H28年度
【エ・文07】創発現象を利用した革新的超低消費電力デバイスの開発	従来のCPUに変わるスピン流演算素子	H35年度
	従来の記憶用素子に代わる電界による磁化制御による記憶用素子	H35年度